



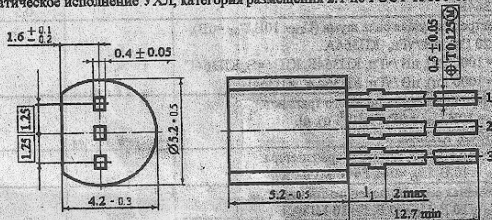
**Транзисторы типа**  
**КП364А, КП364Б, КП364В, КП364Г, КП364Д, КП364Е,**  
**КП364Ж, КП364И**

Код ОКП 6341

**ЭТИКЕТКА**  
**КСЕН.432143.018 ЭТ**

Кремниевые эпитаксиально – планарные полевые с каналом p-типа транзисторы с диффузионным затвором КП364А, КП364Б, КП364В, КП364Г, КП364Д, КП364Е, КП364Ж, КП364И в пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в маломощных усилителях, в схемах зарядочувствительных предусилителей и другой аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69



1 – исток, 2 – сток, 3 – затвор

- 1, 1<sub>1</sub> – неконтролируемая и непригодная для монтажа длина вывода.
2. Позиционный допуск контролируется на расстоянии  $l_1$  max.

Масса – не более 0,3 г.

Тип транзистора указывается цифрами, группа – соответствующей буквой.

Год и месяц изготовления указываются согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Год	Код
2007	V
2008	W
2009	X
2010	A
2011	B
2012	C

Таблица 2

Месяц	Код	Месяц	Код
Январь	1	Июль	7
Февраль	2	Август	8
Март	3	Сентябрь	9
Апрель	4	Октябрь	0
Май	5	Ноябрь	N
Июнь	6	Декабрь	D

**1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

1.1. Основные электрические параметры при  $T_{amb} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
Ток утечки затвора ( $U_{DS} = 0$ В, $U_{GS} = -30$ В), мкА	$I_{GSS}$		10
Ток утечки затвора ( $U_{DS} = 0$ В, $U_{GS} = -10$ В), нА	$I_{GSS1}$		1,0
КП364А, КП364Б, КП364В			0,1
КП364Г, КП364Д, КП364Е			1,0
КП364Ж, КП364И			5,0
Начальный ток стока ( $U_{DS} = 10$ В, $U_{GS} = 0$ В), мА	$I_{DSS}$		
КП364А, КП364Б		0,5	2,5
КП364В, КП364И		1,5	5,0
КП364Г		3,0	12,0
КП364Д		3,0	9,0
КП364Е		5,0	20,0
КП364Ж		0,3	3,0

1	2	3	4
Крутизна характеристики ( $U_{DS}=10 В, U_{GS}=0 В$ , $f=50-1500 Гц$ ), мА/В КП364А, КП364Б, КП364Ж КП364В КП364Г КП364Д КП364Е КП364И	$g_{m}$	1 2 3 2,6 4 2	4 5 7 - - 6
Напряженные отсечки ( $U_{DS}=10 В, I_D=10 мкА$ ), В КП364А, КП364Б КП364В КП364Г, КП364Д, КП364Е КП364Ж КП364И	$U_{GS(от)}$	0,5 1,0 - 0,3 0,5	3 4 8 3 2
Электродвижущая сила шума ( $U_{DS}=10 В, U_{GS}=0 В$ ), ( $f=20 Гц$ ), нВ/ $\sqrt{Гц}$ , КП364А ( $f=1000 Гц$ ), нВ/ $\sqrt{Гц}$ , КП364Б, КП364В, КП364Г ( $f=1000 Гц$ ), нВ/ $\sqrt{Гц}$ , КП364Ж, КП364И	$e_n$ $e_n$ $e_n$		30 20 100
Коэффициент шума полевого транзистора ( $U_{DS}=10 В, U_{GS}=0 В, f=10^6 Гц$ ), дБ КП364Д, КП364Е	F		4
Входная емкость полевого транзистора ( $U_{DS}=10 В, U_{GS}=0 В, f=10 МГц$ ), пФ	$C_{11SS}$		6
Прходная емкость полевого транзистора ( $U_{DS}=10 В, U_{GS}=0 В, f=10 МГц$ ), пФ	$C_{12SS}$		2

1.2 Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

золото - 0,0560 мг, палладий - 0,0013 мг. серебр. 0,6842

Выводы драгоценных металлов не содержат.

1.3 Содержание цветных металлов и их сплавов в одном транзисторе

Цветных металлов не содержится.

## 2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Интенсивность отказов в течение минимальной наработки не более  $3 \times 10^{-7}$  1/ч.

2.2 Нарботка транзисторов  $t_n = 80000$  ч.

2.3 98-процентный срок сохранения транзисторов 12 лет.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества транзисторов требованиям АДЕК.432150.189ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на транзисторы.

Гарантийный срок - 12 лет с момента изготовления.

Светопроницаемость гарантируется конструкцией транзисторов.

Приемочный уровень дефектности: по внешнему виду - 1,5%, по электрическим параметрам - 0,1%.

## 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КП364А, КП364Б, КП364В, КП364Г, КП364Д, КП364Е, КП364Ж, КП364И соответствуют техническим условиям АДЕК.432150.189ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (дата)

Место для штампа ОТК **ОТК-375**

Место для штампа «Перепроверка произведена» **5.12.1977** (дата)

Приняты по \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (дата)

Место для штампа ОТК **ОТК-375**

Цена договорная

## 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Основное назначение транзисторов работа в малопумящих усилителях, в схемах зарядочувствительных преусилителей и другой аппаратуре в диапазоне до 100 МГц.